Рисунки к главе 7



Рис. 7.1.



Рис. 7.2.



Рис. 7.3.



Рис. 7.4.



Рис.7.5.



Рис.7.6.



Рис.7.7.



Рис. 7.8



Рис. 7.9



Рис. 7.10



Рис. 7.11.



Рис. 7.12



Рис.7.13



Рис.7.14

Подписи к рисункам гл.7

Рис.7.1. Сечение фотоотрыва электрона из $5p^6$ оболочки Г. Точки - одночастичный модельный расчет [18], тонкий пунктир и штрих-пунктир – ХФ сечения $5p \rightarrow \varepsilon d$ перехода в форме длины и скорости, соответственно, жирный пунктир и штрих-пунктир - $5p \rightarrow \varepsilon d$ и $5p \rightarrow \varepsilon s$ в ПСФО, сплошная линия - полное сечение $5p^6$ оболочки в ПСФО [14,15].

Рис.7.2. Сечение фотоотрыва электрона из $5s^2$ оболочки Г. Пунктир – приближение ХФ, полученное с оператором длины, штрих-пунктир - приближение ПСФО с учетом влияния только $4d^{10}$ оболочки, сплошная линия - приближение ПСФО с учетом влияния $5p^6$ и $4d^{10}$ оболочек [14], штрих-штрих-пунктир – релятивистское приближение ПСФО с учетом статической перестройки [19].

Рис.7.3. Сечение фотоотрыва для 3s² оболочки Na⁻. Пунктир, штрих-штрих-пунктир – приближения XФ в форме длины и скорости, соответственно, штрих-пунктир - приближение ПСФО [15], точки - приближение ПСФО с учетом поляризационных поправок для вылетающего электрона [20], сплошная линия – метод сильной связи [21].

Рис.7.4. Околопороговое сечение фотоотрыва электронов от отрицательного иона палладия Pd⁻. Пунктир и сплошная линия – парциальное сечение фотоотрыва наружных 5s электронов без учета и с учетом взаимодействия с $4d^{10}$ оболочкой соответственно; штрихпунктир – парциальное сечение фотоотрыва 4d электронов в ПСФО [5].

Рис.7.5. Сечение фотоотрыва 4р электрона Са⁻. Теория: штрих-пунктир – метод уравнения Дайсона с учетом поляризационного взаимодействия фотоэлектрона и остова [11]; пунктир – многоконфигурационное приближение ХФ [25]; сплошная линия – метод R-матрицы [26]. Эксперимент из работ [27-29]. Вертикальные линии показывают положение различных порогов.

Рис.7.6. Сечение фотоотрыва 3*р* электронов от отрицательного иона кремния Si⁻ в окрестности порога 3*s*² оболочки. Сплошная линия – ПСФО, взаимодействие только 3*p*³ электронов; пунктир – ПСФО, с учетом взаимодействия между "3*s*3*p*⁴" резонансом и 3*p* электронами [15,16]; точки – эксперимент [34].

Рис.7.7. Сечение фотоотрыва 2*p* электронов от отрицательного иона бора В⁻ в окрестности порога 2*s*² оболочки. Точки- эксперимент из [42,43]. Теория: пунктир – метод R-матрицы [44]; сплошная линия и штрих-пунктир – комбинированный метод: ПСФО + уравнение Дайсона с операторами длины и скорости, соответственно [38].

Рис.7.8. Поляризационные эффекты в сечении фотоотрыва 4*s* электронов от ОИ хрома Cr⁻. Вычисления проведены в рамках комбинированного метода [40]. Штрих-пунктир – учет поляризации только в основном состоянии для $4s \downarrow$ электрона; сплошная линия и пунктир – метод ПСФО + уравнение Дайсона с 17 каналами при вычислении Σ и с операторами длины и

скорости, соответственно; штрих-штрих-пунктир – то же с учетом только 5 переходов из $4s^{\uparrow}$ уровня.

Рис.7.9. Сечение фотоотрыва 2*s* электрона от ОИ гелия Не⁻. Точки- эксперимент из [45]. Теория: штрих-пунктир и штрих-штрих-пунктир – расчет с скорректированной 2s волновой функцией и ХФ функциями для фотоэлектрона єр с операторами длины и скорости, соответственно; пунктир и сплошная линия – с учетом динамической поляризации комбинированный метод: ПСФО + уравнение Дайсона с операторами длины и скорости, соответственно [39].

Рис.7.10. Сечение фотоотрыва 4*d* электронов от ОИ йода Г. Штрих-пунктир и пунктир – ХФ и ПСФО для 4*d* $\rightarrow \varepsilon f$ парциального сечения соответственно; пунктир с точками – ПСФО для парциального 4*d* $\rightarrow \varepsilon p$ сечения (умноженное на 5); сплошная линия – полное сечение для 4*d* [14,15]; штрих-штрих пунктир – релятивистское ПСФО с учетом статической перестройки [19]. Треугольники – экспериментальные результаты [49]умножены на фактор 1.7.

Рис.7.11. Сечение фотоотрыва 3*d* электронов от Ge⁻ [46]. Штрих-пунктир и пунктир – спинполяризованный метод ПСФО для $3d\downarrow$ и $3d\downarrow$ уровней, соответственно; штрих-штрих-пунктир и сплошная линия – учет статической перестройки в рамках ОПСФО для $3d\downarrow$ и $3d\downarrow$ уровней, соответственно

Рис.7.12. Сечение фотоотрыва для Cr⁻ в окрестности порога внутренней 3р оболочки. Штрих-пунктир и пунктир – парциальное сечение $3d \uparrow \rightarrow \varepsilon f \uparrow$ канала, полученное без учета и с учетом взаимодействия с $3p \downarrow \rightarrow \varepsilon d \downarrow$ переходом, соответственно; сплошная линия – полное сечение фотоотрыва, полученное в рамках ПСФО + уравнение Дайсона с учетом перестройки [40]. Стрелка показывает положение резонанса в $3p \downarrow \rightarrow \varepsilon d \downarrow$ канале.

Рис.7.13. Сечение фотоотрыва 1*s* электронов Li⁻. Точки, квадраты - эксперимент из работ [51,52]. Штрих-пунктир – расчет в рамках R –матрицы [50,51]. Результаты расчета настоящей работы [53] с различными волновыми функциями: пунктир – εs , εp , εd волновые функции в поле Дайсоновского замороженного остова. Сплошная линия - εp функция в поле замороженного остова и перестроенные εs , εd волновые функции в поле 1*s*2*s*2*p* Li. Положение теоретического порога 1*s*2*s*2*p* возбуждения сдвинуто на 0.5 эВ.

Рис.7.14. Сечение фототрыва 1*s* электронов С⁻. Сплошная линия - расчет по теории многих тел [55]. Точки- экспериментальные данные из работы [54], нормированные на теоретическое значение сечения фототрыва в максимуме.